长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途

文献类型：专利

作者 王振友; 吴海信; 毛明生; 倪友保; 黄昌保; 肖瑞春; 戚鸣

发表日期 2015

专利国别 中国

专利号 CN 104695022 A

专利类型 发明

权利人 中国科学院

申请日期 2015

专利申请号 201510103218.4

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/19815]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

作者单位 中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 GB/T 7714 王振友,吴海信,毛明生,等. 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途, 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途, 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途, 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途, 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途, 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途, 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途, 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途, 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途, 长波红外非线性CdGa2Se4的晶体及其生长方法与用途. CN 104695022 A. 2015-01-01.

入库方式： OAI收割
来源： 合肥物质科学研究院

浏览 77 下载 15 收藏 0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。